

	FQD18N20V2TM	
	Hersteller-Teilenummer:	FQD18N20V2TM
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 200V 15A DPAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 1.FQD18N20V2TM.pdf  2.FQD18N20V2TM.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 12702 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FQD18N20V2TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 15A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	12702 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	20 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 15A (Tc) 2.5W (Ta), 83W (Tc) Surface
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 83W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	140 mOhm @ 7.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1080pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQD18N20V2TM-ND

FQD18N20V2TM ist neu im Original, Suche FQD18N20V2TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD18N20V2TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD18N20V2TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD18N20V2TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 15A DPAK</p>	 <p>FQD18N20V2 FAIRCHI FQD18N20V2 FAIRCHI</p>	 <p>FQD18N20V2TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 15A DPAK</p>	 <p>FQD19N10L FAIRCHI FQD19N10L FAIRCHI</p>
 <p>FQD19N10 F FQD19N10 F</p>	 <p>FQD17P06TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 12A DPAK</p>	 <p>FQD19N10L FQD19N10 FAIRCHILD FAIRCHILD SOT-252</p>	 <p>FQD19N10LTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ FQD13N10LTM	↔ FQD13N10LTM-NL	⇒ FQD13N10TM	D FQD13N10TM	↔ FQD13N20D
⊣ FQD14N15	⊛ FQD16N15	D FQD16N25C	⇒ FQD16N25CTM	↔ FQD16N25CTM
⊛ FQD16N25L	⊣ FQD17N08	⊛ FQD17N08L	↔ FQD17N08LTF	↔ FQD17N08LTF
D FQD17N08LTM	⊛ FQD17N08LTM	⊣ FQD17N10	⊛ FQD17P06	↔ FQD17P06TF
⇒ FQD17P06TF	↔ FQD17P06TM	⊛ FQD17P06TM	⊣ FQD18N20V2	↔ FQD18N20V2TM
↔ FQD19N10	⇒ FQD19N10L	D FQD19N10LTM	⊛ FQD19N10LTM	⊣ FQD19N10TF
⊛ FQD19N10TF	D FQD19N10TM	⇒ FQD19N10TM	↔ FQD1N50B	↔ FQD1N50TF
⊣ FQD1N50TF	⊛ FQD1N60C	↔ FQD1N60CTF	⇒ FQD1N60CTF	↔ FQD1N60CTM
⊛ FQD1N60CTM	⊣ FQD1N60TF	⊛ FQD1N60TF	D FQD1N60TM	↔ FQD1N60TM
↔ FQD1N80TM	⊛ FQD1N80TM	⊣ FQD1P50TM	⊛ FQD1P50TM	↔ FQD20N06

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

